

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-285509

(43)Date of publication of application : 13.10.2000

(51)Int.Cl.

G11B 7/24

(21)Application number : 11-095005

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 01.04.1999

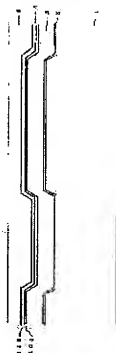
(72)Inventor : KINOSHITA MIKIO
HARIGAI MASATO
SHIBAKUCHI TAKASHI

(54) DRAW TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium using inorganic recording materials and having recording density equal to that of DVD-ROM.

SOLUTION: The optical recording medium has at least a light interference layer 3 on a translucent layer on a substrate 1 and a recording layer 4 on the light interference layer. The recording layer has a 1st recording layer 104 comprising a metal, a metalloid or an alloy of these and a 2nd recording layer 105 comprising Ge. The material of the 1st recording layer is, e. g. Al, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn or the like, its compound or alloy. The translucent layer is, e.g. a thin film of Al, Au or Si. The light interference layer comprises known derivatives such as ZnS.SiO₂, SiO₂, MgF, SiN, InO or ZnO.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J.P.) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-285509

(P2000-285509A)

(43) 公開日 平成12年10月13日 (2000.10.13)

(51) Int.Cl. 分類記号

G11B 7/24

FI

G11B 7/24

522B 5D029

522D

511

535C

535G

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全6頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-95005

(22) 出願日 平成11年4月1日 (1999.4.1)

(71) 出願人 000008747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 木下 幹夫

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72) 発明者 針谷 直人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74) 代理人 100078894

弁理士 小松 秀岳 (外2名)

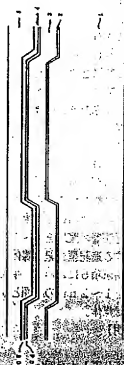
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 追記型光記録媒体

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 DVD-ROMと等容量の記録密度をもつ、無酸素の記録材料を用いた光記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板1上の半透明層上の光干渉層3、該光干渉層上の記録層4を少なくとも有し、かつ、該記録層が金属または半金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層104とGeから成る第2記録層105とを有することを特徴とする追記型光記録媒体である。第1記録層の材質は、Al、Au、Ag、Cu、Pt、Pd、Sb、Te、In、Sn、Zn等で、化合物や合金を含む。半透明層は、Al薄膜、Au薄膜、Si薄膜などである。光干渉層は、ZnS、SiO₂、SiO₂、MgF、SiN、InO、ZnO等公知の誘導体である。



1

【特許請求の範囲】
 【請求項1】 基板上の半透明層、該半透明層上の光干渉層、該光干渉層上の記録層を少なくとも有し、かつ、該記録層が金属、または半金属、あるいはこれらの合金から成る第1記録層とGeから成る第2記録層とを有することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項2】 請求項1においてモジュレーションが60%以上であることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項3】 請求項1または2において第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を30nm以下の範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項4】 請求項1または2において第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を20nm以下とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項5】 請求項3または4において、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が低下することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項6】 請求項2、3、4、または5において光干渉層の屈折率を n 、膜厚を d 、記録波長を λ と表す表式において、これらが、

1. $0.9 \leq n \leq 2.5$
 0. $0.25 \leq nd/\lambda \leq 0.35$
 $600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$
 の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項7】 請求項2、3、4または5において光干渉層の屈折率を n 、膜厚を d 、記録波長を λ と表す表式において、これらが、

1. $0.4 \leq n < 1.6$
 0. $0.33 \leq nd/\lambda \leq 0.41$
 $600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$
 の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項8】 請求項2、3、4または5において光干渉層の屈折率を n 、膜厚を d 、記録波長を λ と表す表式において、これらが、

1. $0.6 \leq n \leq 1.9$
 0. $0.31 \leq nd/\lambda \leq 0.37$
 $600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$
 の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項9】 請求項6において、半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5~15nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項10】 請求項6において、半透明層をAlとし、該Alの膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、レーザービームな

2

どの照射により記録再生が可能な追記型光記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】 レーザービームの照射による記録可能な光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記録媒体などがある。これらの相変化光記録媒体はCD-ROMあるいはDVD-ROMと再生互換性があり、小規模の配布メディアや保存用の媒体として使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 特に大容量メディアであるDVD-ROMと同等量の記録密度の実現が課題となっている。この幅広い普及を図る上で、高記録密度での記録パワーマージンの確保が特に重要な課題である。この確保に関しては、相変化記録材料、合金化可能な2層膜など無機系の記録材料が有利であるが、モジュレーションの不足、あるいはDVD-ROMなどDPD (Differential Phase Detection) を使用するドライブのトラッキング信号強度が不足する等の問題があった。特に、特開6-171236に開示されるAl-Ge2層膜は熱処理後の反射率が上昇するが、ROM互換を実現する上では、熱処理後の反射率を低下させ、かつ、上記60%以上のモジュレーションを得ることがAl-Ge2層膜を使用する光記録媒体の課題となっていた。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明による追記型光記録媒体は、基板上の半透明層、この上の光干渉層、光干渉層上の記録層を少なくとも有する。記録層は金属、半金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層と、第1記録層と合金化可能なGeから成る第2記録層を有する。

【0005】 第1記録層の材質は、Al、Au、Ag、Cu、Pt、Pd、Sb、Te、In、Sn、Zn等で、化合物や合金を含む。基板の材質はポリカーボネート、ガラスなどの公知の透明体で、この上の半透明層は、半透明Al薄膜、半透明Au薄膜、半透明Si薄膜など、吸収を有する材質で、所定の透過率、反射率を有する半透明体である。相変化材料も半透明層として使用可能である。光干渉層はZnS-SiO₂、SiO₂、MgF₂、Si-N、In-O、Zn-O等公知の誘電体である。本発明の第2は、上記において、モジュレーションが60%以上のものが該当する。

【0006】 請求項3に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、第1記録層の膜厚を30nm以下とする。請求項4に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、この第1記録層の膜厚を20nm以下の範囲とする。

【0007】 さらに、請求項5に記載の追記型光記録媒体

4

*意であるが、これにより、記録時の反射率変化が規定される。DVD-ROMとの互換をとるという観点から、記録マーク部分の反射率を低下させる必要があり、これは、記録層の層構成が、読みと書きの入射面に近い側に第1記録層が配置される場合に実現する。この場合過度に第1記録層膜厚が大きい場合には、光吸収の低下、あるいは熱拡散の増大により記録感度の悪化、あるいは、ジッタの増加が問題になり、好ましくない記録層膜厚には上限がある。また、第1記録層及び第2記録層の膜厚は、合金化前後の記録層による反射光の振幅及び位相差に関連するパラメータであり、モジュレーション等に影響を与える。

【0015】

【発明の実施の形態】図1に本発明に使用される追記型光記録媒体の層構成を示す。ポリカーボネート基板1上に記録層2、光干渉層3、第1記録層104及び第2記録層105から成る記録層4、樹脂から成る環境保護層5が順次堆積される。光吸収層2はAuまたはAlからなる。光干渉層3は $ZnS \cdot SiO_2$ または SiO_2 である。第1記録層104はAu、Ag、Cu、Al等である。第2記録層105はGeから成る。この構成では、記録後のマーク面の反射率は低下する。基板のトランシmittanceは0.74 μm である。

【0016】表1に、本構成の追記型光記録媒体の記録波長635nm、記録線幅7μm、データピット長2.67μm/bitでの記録にたいして反射率・モジュレーションの第2記録層膜厚依存性を示す。表1で、Auから成る光吸収層の2膜厚は7nm、ZnS・SiO₂から成る光干渉層3の膜厚は95nm、Alから成る第1記録層104の膜厚は95nm、記録再生波長は635nmである。第2記録層105の膜厚が5nm近傍、及び100nm近傍で大きなモジュレーションが得られる。Geは屈折率の実部が大きく、吸収係数が比較的小さいため、Geそのものも干渉層として作用し、散乱率やモジュレーション、及び記録状態と未記録状態の反射光の位相差に影響を与える。ジッタなどの改善のために、Ge層の上に付加的な放熱層、あるいは干渉層を堆積しても良い。

【0017】
【表1】

20

30

40

1

11

+

1	2
3	4

2

225

245

10

1998

100

50

52

	第1配極厚(mm)	第1配極厚(mm)	第2配極厚(mm)	反折率(%)	モジュール(20/20)
比較例1	Al	10	0	25.8	0.8
実施例1	Al	10	10	14.5	25.0
実施例2	Al	10	20	23.8	30.0
実施例3	Al	10	30	30.8	31.5
実施例4	Al	10	50	30.8	30.0
実施例5	Al	10	70	31.0	29.0
実施例6	Al	10	100	30.7	28.5

【0018】表2に第1記録層104がA_gの場合のモジュレーションは低下する。また、記録感度に関しては、熱伝導及びジュレーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す図10及び図11に示すように、第1記録層の光吸収率の関係でA_g膜厚が薄い場合の方が好ましい。A_g膜厚が3.0nmを上回る場合にはモジュレーションが50%好ましい。即ち、A_g第1記録層の膜厚が薄い場合に、

は、記録レーザービームの吸収が小さく、かつ、熱伝導による熱拡散が大きく、加熱に多大なエネルギーを要する。この点からもAg膜厚は30nm以下が好ましい。*

*【0019】

【表2】

半透明層Au1nm、光干渉層ZnSSiO₂25nm

記録層	第1記録層材料	第1記録層膜厚(nm)	第2記録層膜厚(nm)	反射率(%)	モジュレーション(%)
実測値12	Ag	0	30	19.3	44.8
実測値17	Ag	5	30	21.0	46.7
実測値18	Ag	10	30	28.0	50.0
実測値19	Ag	15	30	34.2	51.6
実測値11	Ag	20	30	42.0	52.1
実測値13	Ag	30	30	51.8	52.1

【0020】表3に、第1記録層がAlの場合のモジュレーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。AlはAgと比較して、吸収係数が大きく、モジュレーションの極大を与える膜厚は約20nmである。上記と同※

10※様に記録感度の観点からも、Al膜厚は20nm以下が好ましい。

【0021】

【表3】

半透明層Au1nm、光干渉層ZnSSiO₂25nm

記録層	第1記録層材料	第1記録層膜厚(nm)	第2記録層膜厚(nm)	反射率(%)	モジュレーション(%)
実測値12	Al	0	30	22.2	52.2
実測値14	Al	5	30	25.2	52.2
実測値15	Al	10	30	30.0	52.2
実測値16	Al	15	30	35.0	52.2
実測値17	Al	20	30	42.0	52.2
実測値18	Al	25	30	42.4	52.2
実測値19	Al	30	30	44.8	52.1

【0022】表4に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が2.17であるZnS・SiO₂薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。第1記録層はAl:10nmで、第2記録層はGe:30nmである。

20※値があり、nd/λが0.25~0.35の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0023】

【表4】

第1記録層Al10nm、第2記録層Ge30nm

記録層	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層ZnSSiO ₂ 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
実測値19	7	65	0.118	45.5	44.8
実測値20	7	70	0.222	52.2	46.7
実測値21	7	75	0.235	57.5	50.0
実測値22	7	80	0.240	57.5	51.6
実測値23	7	85	0.245	57.5	52.1
実測値24	7	90	0.248	57.5	52.1
実測値25	7	100	0.252	57.5	52.1
実測値26	7	110	0.255	57.5	52.1

【0024】表5に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が1.457であるSiO₂薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚160nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/λ☆

☆が0.33~0.41の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0025】

【表5】

第1記録層Al10nm、第2記録層Ge30nm

記録層	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層SiO ₂ 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
実測値27	10	130	0.210	42.0	50.0
実測値28	10	140	0.220	42.0	50.0
実測値29	10	150	0.230	42.0	50.0
実測値30	10	160	0.240	42.0	50.0
実測値31	10	170	0.250	42.0	50.0
実測値32	10	180	0.260	42.0	50.0

【0026】表6に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が1.766であるAl₂O₃薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚120nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/λ◆

◆が0.31~0.37の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0027】

【表6】

第1記録層Al10nm、第2記録層Ge30nm

記録層	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層Al ₂ O ₃ 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
実測値33	8	90	0.250	42.0	50.0
実測値34	8	100	0.260	42.0	50.0
実測値35	8	110	0.270	42.0	50.0
実測値36	8	120	0.280	42.0	50.0
実測値37	8	130	0.290	42.0	50.0
実測値38	8	140	0.300	42.0	50.0
実測値39	8	150	0.310	42.0	50.0

【0028】表7に半透明層をAuとした場合の反射率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記

【0029】表8に半透明層をAuとした場合の反射率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記

録層は第1記録層がA1:10nm、第2記録層がGe:30nmである。Au膜厚5~15nmでモジュレーションは60%を上回る。

表7 第1記録層A1:10nm、第2記録層Ge:30nm

比較例	半透明層A1膜厚(nm)	半透明層Ge膜厚(nm)	n/A	反射率(%)	モジュレーション(%)
実施例33	0	95	0.325	30.4	50.0
実施例34	1	95	0.325	44.1	55.0
実施例35	2	95	0.325	30.5	53.0
実施例36	3	95	0.325	25.9	58.0
実施例37	4	95	0.325	21.8	70.0
実施例38	5	95	0.325	17.9	81.5
実施例39	10	95	0.325	11.9	88.0

【0030】表8に半透明層をA1とした場合の、反射率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記録層は、第1記録層がA1:10nm、第2記録層がGe:30nmである。A1膜厚1~2nmでモジュレーションは60%を上回る。これ以外に、AgInSbTe、GeSbTeなどの相変化材料も半透明層として使

用可能であるが、この場合、半透明層は記録時の熱エネルギーにより結晶化するので、光学定数が変化し、補助的な記録層としての作用も有する。

【0031】

【表8】

表8 第1記録層A1:10nm、第2記録層Ge:30nm

比較例	半透明層A1膜厚(nm)	半透明層Ge膜厚(nm)	n/A	反射率(%)	モジュレーション(%)
実施例40	0	95	0.325	30.4	50.0
実施例41	1	95	0.325	32.7	64.8
実施例42	2	95	0.325	15.4	65.0
実施例43	3	95	0.325	7.0	69.0
実施例44	5	95	0.325	17.9	80.0

【0032】以上のように本発明では、Geと合金化可能な第1記録層を有する光記録媒体において、記録状態の反射率が低下する層構成で、モジュレーション60%以上を得た。なお、本発明に使用される光記録媒体の層構成は上記に限られず、公知の光記録媒体の任意の構造が可能である。

【0033】

【発明の効果】本発明は上記のごとくしたが故に以下の効果が生じた。パワーマージンに優れた無機系追記型光記録媒体のモジュレーションが向上し、DVD-ROM等の汎用ドライブで再生可能な追記型光記録媒体を得

★た。

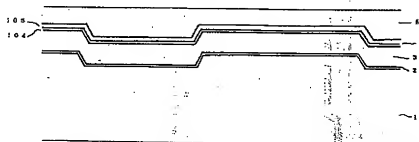
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の追記型光記録媒体の層構成を示す。

【符号の説明】

- 1 ポリカーボネート基板
- 2 光吸収層
- 3 光干渉層
- 4 記録層
- 5 環境保護層
- 104 第1記録層
- 105 第2記録層

【図1】



(16) 000-285509 (P2000-285509A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

G11B 7/24

識別記号

538

F I

G11B 7/24

テ-マコード (参考)

538A

(72) 発明者 芝口 孝

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

Fターム(参考) 5D029 JA01 JB03 JB17 JB35 JC20
LB01 LB67 LC06 MA02 MA03